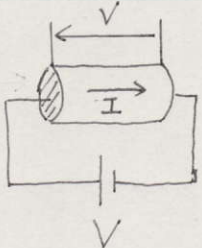
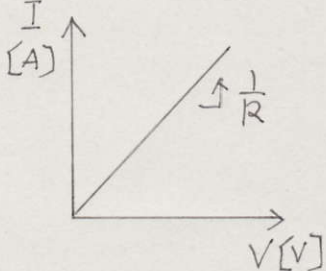
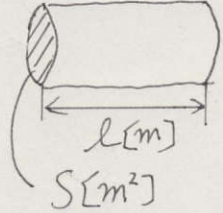
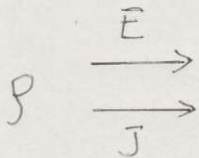
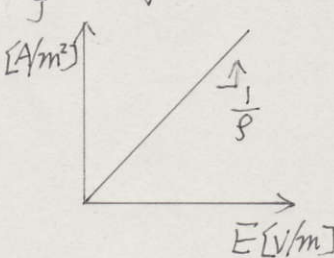


① 抵抗体の特性の基本

	イメージ	特性	式
実体			$I = \frac{1}{R} V$ $R[\Omega]$ は実用値 \nearrow 抵抗
形状で規格化			$J = \frac{I}{S} [A/m^2]$ \nearrow 電流密度 $E = \frac{V}{l} [V/m]$ \nearrow 電界
物性			$J = \frac{1}{\rho} E$ $\rho[\Omega m]$ は物性値 \nearrow 抵抗率

実用値と物性値の関係

$$R = \frac{V}{I} = \frac{V/l}{I/S} \frac{l}{S} = \frac{E}{J} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S} \quad \therefore R = \rho \frac{l}{S} [\Omega]$$

物性値の表し方

$$\frac{1}{\rho} = \sigma$$

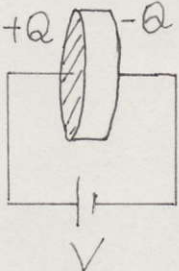
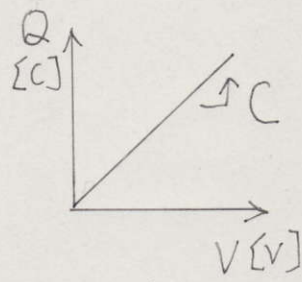
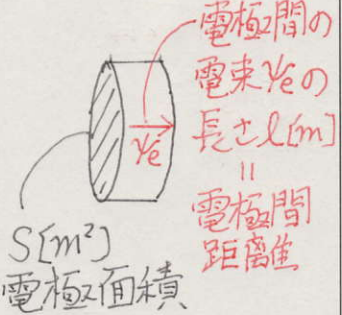
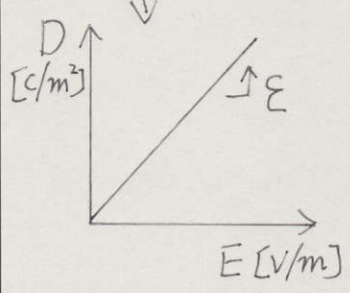
物性値 (導電率 $[S/m]$) \nearrow σ

物性値 (抵抗率 $[\Omega m]$) \nearrow ρ

例: 金属の中で最も抵抗率が低いのは

$$Ag: \rho(0^\circ C) = 1.47 \times 10^{-8} [\Omega m]$$

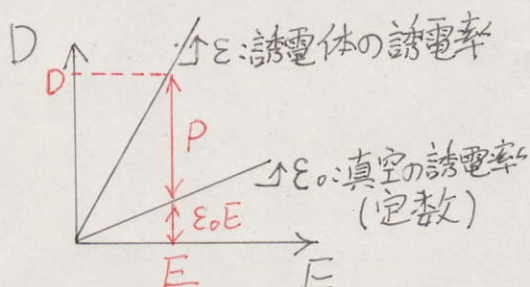
② 誘電体の特性の基本

	イメージ	特性	式
実体			$Q = C V$ C [F] は実用値 ↑ キャパシタンス
形状で規格化			$E = \frac{V}{d} \text{ [V/m]}$ ↑ 電界 $D = \frac{Q}{S} \text{ [C/m²]}$ ↑ 電束密度
物性	$\begin{matrix} \epsilon & \longrightarrow & E \\ & \longrightarrow & D \end{matrix}$		$D = \epsilon E$ ε [F/m] は物性値 ↑ 誘電率

実用値と物性値の関係

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q/S}{V/d} \frac{S}{d} = \frac{D}{E} \frac{S}{d} = \epsilon \frac{S}{d} \quad \therefore C = \epsilon \frac{S}{d}$$

物性値の表し方



(例: 4タン酸バリウム (BaTiO₃))
εₛ (室温) ≒ 5000

$$\begin{aligned} D &= \epsilon E && \text{物性値 (誘電率)} \\ &= \epsilon_0 E + P && \text{分極 [C/m²]} \\ &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) E && \text{物性値 (分極率または電気感受率 } \chi_e = \frac{P}{\epsilon_0 E} \text{)} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_s E && \text{物性値 (比誘電率 } \epsilon_s = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \text{)} \end{aligned}$$

← 強誘電体の場合 $\chi_e \gg 1$ なので
 $\epsilon_s = 1 + \chi_e \doteq \chi_e$

③ 磁性体の特性の基本

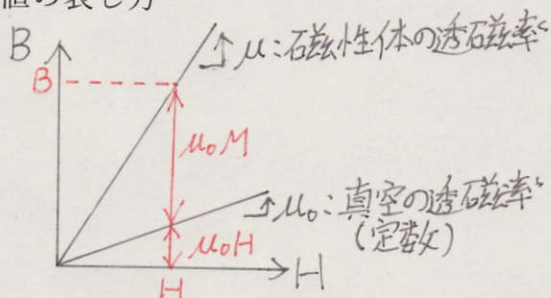
	イメージ	特性	式
実体	<p>磁束 Ψ_m [Wb] 長さ l [m] (平均磁路長) 磁束鎖交数 Φ $\Phi = N \Psi_m$ ↑ コイルの巻数 コイルの面積 S [m²] (コアの断面積)</p>	<p>Φ [Wb] ↑ L ↑ I [A]</p>	$\Phi = L I$ L [H] は実用値 ↑ 自己インダクタンス
形状で規格化	<p>コイルを貫く磁束 Ψ_m の平均長さ l [m] 巻数 N コイルが作る面積 S [m²]</p>		$\Psi_m = S B$ であるから ↑ 磁束密度 $\Phi = N S B$ $\begin{cases} B = \frac{\Phi}{N S} \text{ [Wb/m}^2\text{]} \\ \text{↑ 磁界} \text{ [T]} \\ H = N \frac{I}{l} \text{ [A/m]} \end{cases}$
物性	μ ↓ B H	<p>B [Wb/m²] ↑ μ ↑ H [A/m]</p>	$B = \mu H$ μ [H/m] は物性値 ↑ 透磁率

実用値と物性値の関係

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\Phi / N S}{N I / l} = \frac{B}{H} \frac{N^2 S}{l} = \mu \frac{N^2 S}{l} \quad \therefore L = N^2 \mu \frac{S}{l} \text{ [H]}$$

↑ 努力が報われる N^2

物性値の表し方



物性値 (透磁率 [H/m])

$$B = \mu H$$

磁化 [A/m]

$$= \mu_0 (H + M)$$

物性値 (磁化率 $\chi_m = \frac{M}{H}$)

$$= \mu_0 (1 + \chi_m) H$$

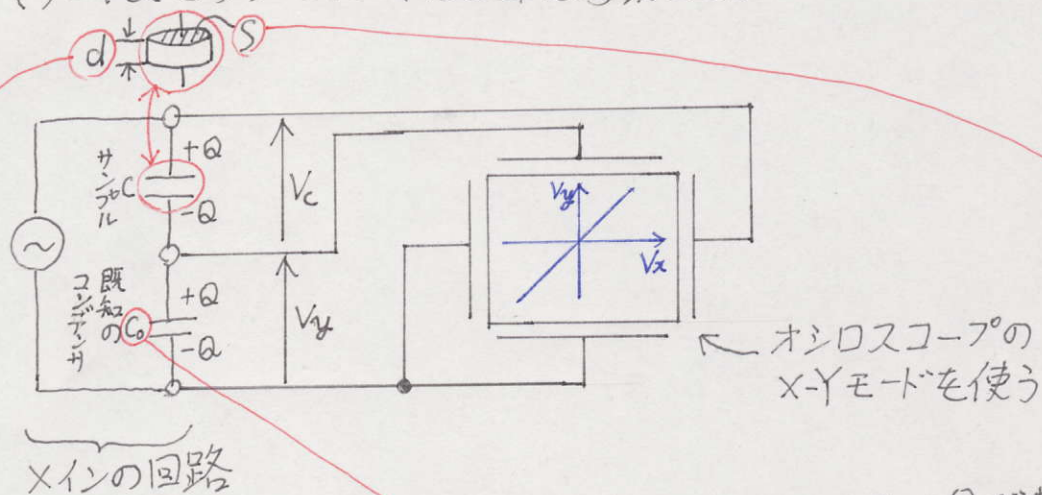
物性値 (比透磁率 $\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0}$)

$$= \mu_0 \mu_s H$$

(例) Mn-Zn系フェライト ($Mn_{0.5}Zn_{0.4}Fe_{2.1}O_4$) ← 強磁性体の場合 $\chi_m \gg 1$ なので
 $\mu_s \doteq 10,000 \doteq \chi_m$
 $\mu_s = 1 + \chi_m \doteq \chi_m$

④ 誘電体の測定

- 。ソーヤ・タワー回路を使った測定法。
(ソーヤ氏とタワー氏が1930年に考案した)



$$V_x = V_c + V_y$$

$$= \frac{Q}{C} + \frac{Q}{C_0}$$

ここで $C \ll C_0$ とする
(実際の測定では $\frac{C_0}{C} > 25$ とする)

$$\therefore \frac{Q}{C} = V_c \quad \leftarrow \text{サンプル両端の電圧}$$

$$\therefore E = \frac{1}{d} V_x \quad \leftarrow \text{スケール変換係数}$$

すなわち、オシロスコープの横軸のレンジ(スケール)を $\frac{1}{d}$ 倍にすれば、横軸を電界として読むことができる。

$$V_y = \frac{Q}{C_0} \quad \leftarrow C_0 \text{ の } Q \text{ であるが、サンプル } C \text{ の } Q \text{ と同じ}$$

$$= \frac{S}{C_0} \frac{Q}{S}$$

$$= \frac{S}{C_0} D$$

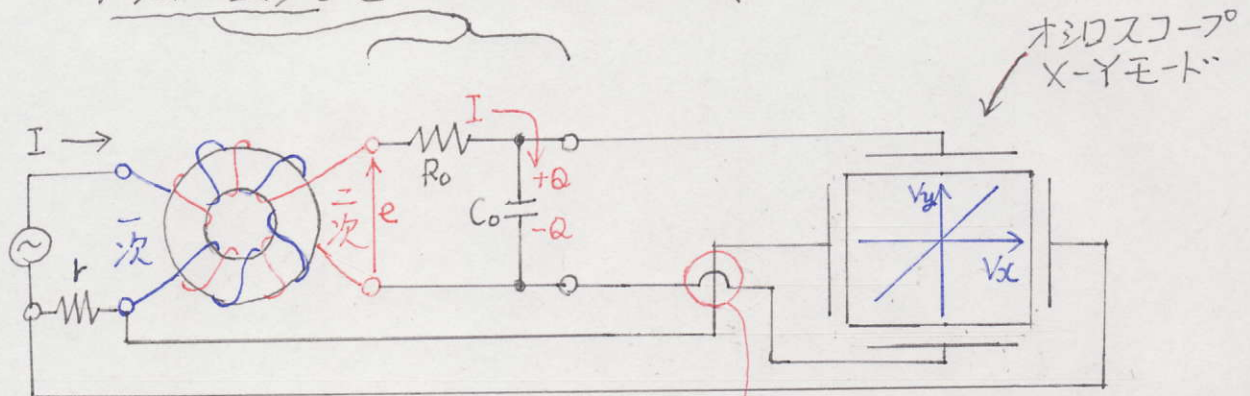
$$\therefore D = \frac{C_0}{S} V_y \quad \leftarrow \text{スケール変換係数}$$

すなわち、オシロスコープの縦軸のレンジ(スケール)を $\frac{C_0}{S}$ 倍にすれば、縦軸を電束密度として読むことができる。

実際の測定では、サンプルの d と S 、既知のコンデンサの C_0 については、値がわかっている。

⑤ 磁性体の測定

積分回路を使った測定法



オシロスコープ
X-Yモード

理解しやすい様にブリッジしているが、
実際は、オシロスコープ内部で結合
している

$$V_x = r I$$

$$\therefore H = \frac{N_1}{lr} V_x$$

←スケール変換係数

(ここで
・ N_1 は一次の巻き数
・ l はコアの形状から
求めた平均磁路長)

すなわち、オシロスコープの横軸の
レンジ(スケール)を $\frac{N_1}{lr}$ 倍にすれば
横軸を磁界として読むことが
できる。

すなわち、オシロスコープの縦軸の
レンジ(スケール)を $\frac{C_0 R_0}{N_2 S}$ 倍すれば
縦軸を磁束密度として読むことが
できる

実際の測定では、コアの平均磁路長と
断面積は形状から求めることができる。
 C_0 と R_0 は値がわかっている。
 N_1 と N_2 は自分で巻くので値はわかる。

$$V_y = \frac{Q}{C_0}$$

$$= \frac{1}{C_0} \int I dt$$

$$= \frac{1}{C_0} \int \frac{e}{R_0 + j\omega C_0} dt$$

(ここで $R_0 \gg \frac{1}{\omega C_0}$ とする
(実際の測定では、 $\omega R_0 C_0 > 25$ とする))

$$\approx \frac{1}{C_0 R_0} \int e dt$$

(ファラデーの法則より
 $e = -\frac{d\phi}{dt}$)

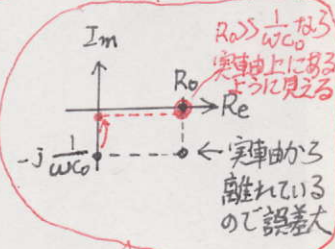
$$= -\frac{1}{C_0 R_0} \int \frac{d\phi}{dt} dt = -\frac{1}{C_0 R_0} \phi$$

$$= -\frac{N_2 S}{C_0 R_0} B$$

$$\therefore B = (-) \frac{C_0 R_0}{N_2 S} V_y$$

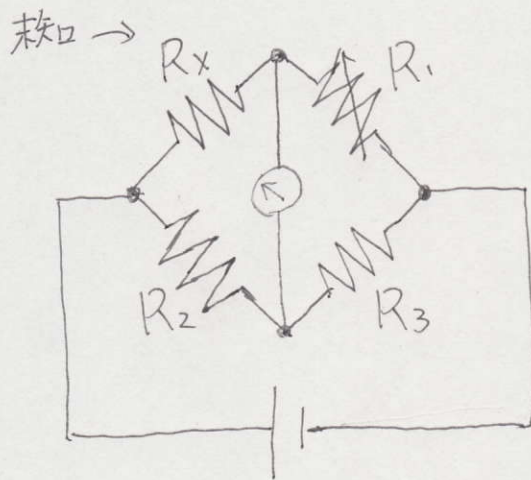
←スケール変換係数

ここでマイナス記号は気にしないで。
良い(オシロスコープに傾きが負の
線が表示されたらコイルの結線を
逆にするか、オシロスコープのスイッチを
押すかなどして傾き正の線を表示
させれば良い。
・ N_2 は二次の巻き数
・ S はコアの断面積



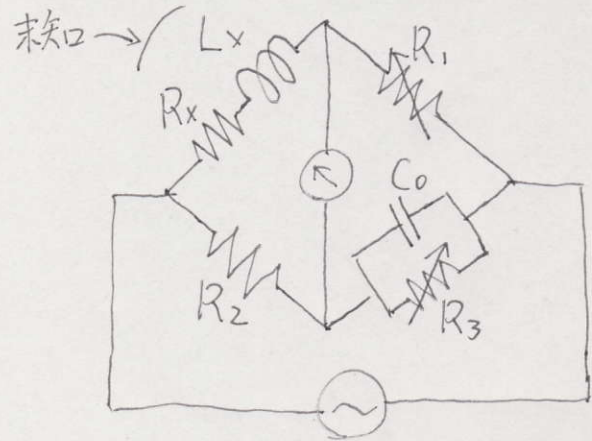
⑥ ユニバーサルブリッジを用いたLの測定

直流(DC)ブリッジ



交流(AC)ブリッジ

↑これを測定に応用したものが
ユニバーサル(万能)ブリッジ



ブリッジが平衡 (I=0) になるとき

$$R_x R_3 = R_1 R_2$$

$$\therefore R_x = \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$(R_x + j\omega L_x) \frac{1}{\frac{1}{R_3} + j\omega C_0} = R_1 R_2$$

$$R_x + j\omega L_x = \frac{R_1 R_2}{R_3} + j\omega C_0 R_1 R_2$$

$$\therefore \begin{cases} R_x = \frac{R_1 R_2}{R_3} \\ L_x = \omega C_0 R_1 R_2 \end{cases}$$

⑦単位 (Unit) の話. (これで最後です)

部屋の広さは、 22 m^2 ? \rightarrow 12畳と言った方がわかりやすい
 古の単位系からは変えにくい!!

	SI単位系 (m, kg, sを使っている)	CGS電磁単位系 (cm, g, sを使っている)
B	1 $\frac{[\text{wb}/\text{m}^2]}{[\text{T}]}$	10^4 [Gauss]
H	1 [A/m]	$4\pi \times 10^{-3}$ [Oe] エルステッド
μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]	1 [emu]
\downarrow $4\pi \times 10^{-7} \frac{[\text{T}]}{[\text{A}/\text{m}]} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^4 [\text{Gauss}]}{4\pi \times 10^{-3} [\text{Oe}]}$ $= 1 [\text{emu}]$		

$$\gamma [\text{Gauss}] = \frac{\gamma}{10^4} [\text{T}]$$

$$\chi [\text{Oe}] = \frac{\chi}{4\pi} \times 10^3 [\text{A}/\text{m}]$$

2学期の実験でCGS電磁単位系で測定結果が出る装置がありますが、レポート作成の際に、SI単位系に変換して下さい。